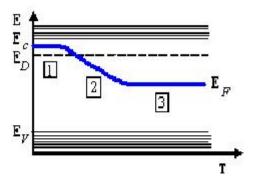
09.03.04_Программная инженерия(Очная)_ПС <u>Курсы</u> <u>ФИиВТ</u> 11_Разработка программных систем Раздел 2 "Основы физики твердого тела" <u>(09.03.04_11_4 сем_о)Физика</u> Демо-вариант теста К-2 _ 2024 Тест начат Понедельник, 20 Май 2024, 12:44 Состояние Завершенные **Завершен** Понедельник, 20 Май 2024, 13:07 Прошло 22 мин. 19 сек. времени Баллы 15,25/21,00 **Оценка 7,26** из 10,00 (**73**%) Вопрос 1 Частично правильный Баллов: 0,50 из 1,00 Приведите в соответствие выражения, приведенные ниже: полупроводник Если валентная зона при T=0°К частично заполнена электронами, то это ... Если валентная зона при T=0°К **полностью заполнена** электронами, а ширина запрещенной зоны **более** диэлектрик **2 3B**, TO **3**TO ... Ваш ответ частично правильный. Вы правильно выбрали 1. **В**опрос **2** Верно Баллов: 1,00 из 1,00 У вещества имеется перекрытие зон, причем нижняя зона заполнена, а верхняя пуста, но перекрывается нижней. Данное вещество

является ...

Выберите один ответ:

- это зависит от температуры
- диэлектриком
- это зависит от ширины зон
- полупроводником
- металлом ✔

Вопрос **3** Неверно Баллов: 0,00 из 1,00



На рисунке изображена температурная зависимость уровня Ферми донорного полупроводника. Область температур, соответствующая собственной проводимости обозначена цифрой

Выберите один ответ:

- **2**
- О 1и2
- 0 1 x
- 2и3

Ваш ответ неправильный.

Вопрос **4**

Неверно

Баллов: 0,00 из 1,00

Удельное сопротивление проводников зависит от:

Выберите один или несколько ответов:

- размеров кристалла **
- ☑ средней длины свободного пробега электронов в металле ✔
- ✓ средней тепловой скорости электронов ✔
- монцентрации электронов в металле 🗸
- средней скорости направленного движения электронов 🗙

Ваш ответ неправильный.

Вопрос 5
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
Электроны в металле при T=0°K обладают следующими свойствами:
Выберите один или несколько ответов:
✓ Распределение электронов по состояниям описывается функцией 1/(exp((E-E _f)/kT) + 1) ✓
■ Распределение электронов по состояниям описывается функцией 1/(exp(E/kT) - 1)
☑ Все состояния до уровня Ферми заняты электронами 🗸
□ Часть состояний ниже уровня Ферми свободны
Распределение электронов по состояниям описывается функцией exp(-E)/kT)
Ваш ответ верный.
Вопрос 6
Баллов: 1,00 из 1,00
Средняя кинетическая энергия электронов в металле при комнатных температурах обычно много больше <i>кТ</i> . Объяснение этого связано с
OBASCITO C
Выберите один ответ:
О туннелированием электронов
О расщеплением энергетических уровней
○ корпускулярно – волновым дуализмом
принципом Паули ✓
⊚ принципом Паули ✔

Вопрос 7
Верно
Баллов: 1,00 из 1,00
На рисунке представлена схема энергетических зон полупроводника <i>p</i> – типа. ———————————————————————————————————
Выберите один ответ: валентную зону уровень Ферми при 0 К ✓ зону проводимости уровень Ферми при Т больше 0 К акцепторный уровень
ваш ответ верпыи.
Вопрос 8 Неверно Баллов: 0,00 из 1,00
Вопрос 8 Неверно
Вопрос 8 Неверно Баллов: 0,00 из 1,00 Укажите верные утверждения для полупроводника n-типа : Выберите один или несколько ответов:
Вопрос 8 Неверно Баллов: 0,00 из 1,00 Укажите верные утверждения для полупроводника п-типа : Выберите один или несколько ответов: Уровень Ферми при T = 0° К находится между донорным уровнем и дном зоны проводимости ✓
Вопрос 8 Неверно Баллов: 0,00 из 1,00 Укажите верные утверждения для полупроводника n-типа : Выберите один или несколько ответов: Уровень Ферми при T = 0° К находится между донорным уровнем и дном зоны проводимости ✓ Энергия активации заряда равна половине энергии донорного уровня, отсчитанного от дна зоны проводимости ×
Вопрос 8 Неверно Баллов: 0,00 из 1,00 Укажите верные утверждения для полупроводника п-типа : Выберите один или несколько ответов: Уровень Ферми при T = 0° К находится между донорным уровнем и дном зоны проводимости ✓ Энергия активации заряда равна половине энергии донорного уровня, отсчитанного от дна зоны проводимости ✓ Энергия активации заряда равна энергии донорного уровня, отсчитанного от дна зоны проводимости ✓
Вопрос 8 Неверно Баллов: 0,00 из 1,00 Укажите верные утверждения для полупроводника n-типа : Выберите один или несколько ответов: Уровень Ферми при T = 0° К находится между донорным уровнем и дном зоны проводимости ✓ Энергия активации заряда равна половине энергии донорного уровня, отсчитанного от дна зоны проводимости ×
Вопрос 8 Неверно Баллов: 0,00 из 1,00 Укажите верные утверждения для полупроводника п-типа : Выберите один или несколько ответов: Уровень Ферми при T = 0° К находится между донорным уровнем и дном зоны проводимости ✓ Энергия активации заряда равна половине энергии донорного уровня, отсчитанного от дна зоны проводимости ✓ Энергия активации заряда равна энергии донорного уровня, отсчитанного от дна зоны проводимости ✓

Вопрос 9	
Верно	
Баллов: 1,00 из 1,00	

Укажите, в каких координатах надо построить графики, чтобы зависимости были <u>линейными функциями.</u>

Здесь Т - температура в градусах Кельвина, t - температура в градусах Цельсия.

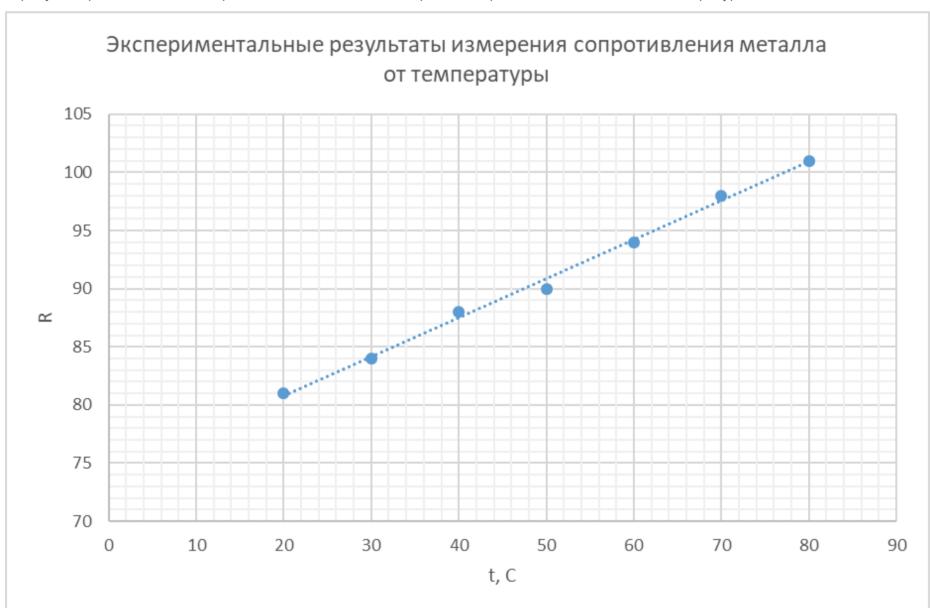
R по оси У	для металла	~
t по оси X	для металла	~
In R по оси У	для полупроводника	~
1/Т по оси X	для полупроводника	~

Ваш ответ верный.

Вопрос **10** Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

На рисунке представлены экспериментальные данные измерения сопротивления металла от температуры:



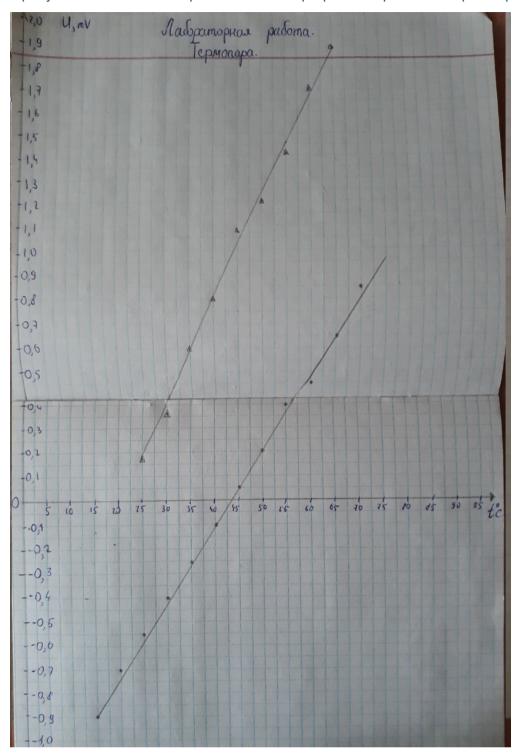
Угловой коэффициент прямой равен...

Ответ: 0,33 ✓

Вопрос 11					
Верно Баллов: 1,00 из 1,00					
При контакте двух разнородных металлов <u>часть электронов из мета</u>	<u>алла 1 пере</u>	шла в ме	талл 2		
После установления равновесия потенциал металла 1 стал		больше	Э	~	
После установления равновесия потенциальная энергия металла 1	стала	меньше	е	~	
Энергия Ферми в металле 2 была		меньше	е	~	
Энергия Ферми в металле 1 была		больше	Э	~	
Ваш ответ верный.					
Вопрос 12 Верно					
Баллов: 1,00 из 1,00					
Концы проводов из двух разнородных металлов спаяли.					
Контакты поместили в сосуды с различной температурой.					
Концентрация высокоэнергичных электронов у горячего контакта	увеличи	ится	~		
Концентрация фононов у холодного контакта	уменьш	ІИТСЯ	~		
Разность энергий Ферми металлов у горячего контакта	увеличи	ится	~		
Paul atrot populi iš					
Ваш ответ верный.					

Баллов: 0,00 из 1,00

На рисунке показаны экспериментальные графики напряжения термопары от температуры:



Для нижнего графика (значения - точки) удельная термо-эдс (в мкВ/град) равна...

Ответ: 0,004

Вопрос 14 Частично правильный			
Баллов: 0,25 из 1,00			
Dailiob. 0,20 vis 1,00			
			Way o " " " " To The The To The The To The The To The
p-n-переход подключили к внешнему источнику тока, и	причем "-" присо	единили к р-полупроводни	ку, а "+" к n-полупроводнику.
Укажите последствия такого включения:			
Выберите один или несколько ответов:			
☑ объем области контакта увеличится ✔			
✓ тока основных носителей не будет ✔			
✓ объем области контакта уменьшится 🗙			
ток <u>неосновных</u> носителей останется неизменных	M X		
Ваш ответ частично правильный.			
Вы выбрали слишком много вариантов.			
Вопрос 15			
Верно			
Баллов: 1,00 из 1,00			
Укажите, как будут меняться свойства полупроводник	ового диода при	различных температурах:	
П			
При понижении температуры диода ток <u>неосновных</u> н	осителеи	уменьшается	✓
При повышении температуры диода ток <u>неосновных</u> н	носителей	увеличивается	~
При понижении температуры диода ток <u>основных</u> нос	ителей	уменьшается	✓
При повышении температуры диода ток <u>основных</u> нос	сителей	увеличивается	✓
Ваш ответ верный.			
·			
- 46			
Вопрос 16 Верно			
Баллов: 1,00 из 1,00			
При контакте 2-х типов полупроводников образовался	я p-n-переход.		
К контакту подключили внешний источник напряжения включение).	я, причем <u>"плюс"</u>	<u>- к р-полупроводнику, "ми</u>	<u>нус" - к n-полупроводнику (</u> прямое
Если напряжение на контакте <u>увеличивать,</u> то при это	DM		
Обратный ток будет уменьшаться .	нет	~	
Прямой ток будет увеличиваться.	да	~	
<u>Ширина</u> контактного барьера будет уменьшаться.	да	~	
Высота контактного барьера будет уменьшаться.	да	~	

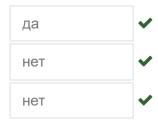
Вопрос **17** Верно Баллов: 1,00 из 1,00

Проводник перешел в сверхпроводящее состояние. При этом...

Его температура стала меньше критической

Плотность тока в нем может быть любой, т.к. нет омического сопротивления

Его можно помещать в магнитное поле любой величины



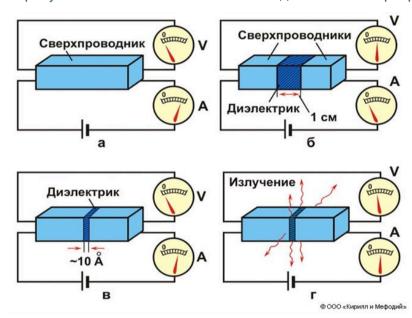
Ваш ответ верный.

Вопрос **18**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00

На рисунке показано несколько схем подключения сверхпроводников к внешнему источнику напряжения.



При этом....

Схема б соответствует стационарному эффекту Джозефсона

Схема г соответствует нестационарному эффекту Джозефсона

Схема в соответствует стационарному эффекту Джозефсона

Для схемы а выполняется закон Ома



Вопрос **19**Частично правильный

Баллов: 0,50 из 1,00

Приведите в соответствие указанные утверждения:

Если населенность верхнего энергетического уровня **больше**, то такая среда описывается

Если населенность верхнего энергетического уровня **меньше**, то такая среда называется



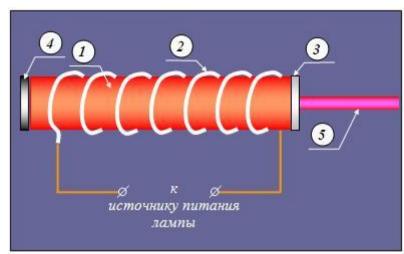
Ваш ответ частично правильный.

Вы правильно выбрали 1.

Вопрос **20**

Верно

Баллов: 1,00 из 1,00



На рисунке представлена структура лазера:

Приведите в соответствие название элемента и его номер:

Активная среда	1	~
Зеркало	4	~
Полупрозрачное зеркало	3	~
Лазерный луч	5	~

Вопрос 21		
Верно		
Баллов: 1,00 из 1,00		
На рисунке представлены уровни энергии и переходы в ла	зере.	
Приведите в соответствие следующие утверждения:		
Вынужденное излучение происходит между уровнями	E2 - E1	~
Спонтанное излучение происходит между уровнями	E3 - E2	~
		*
Спонтанное излучение происходит между уровнями	Е3 - Е2	*
		*
Е2 - этоуровень.		*
		*